## Khuếch đượ tin hiệu nhỏ dung FET

1) Cơ sở lý thuyết

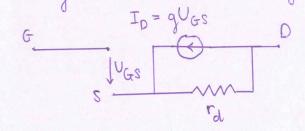
FET là linh kiến điển từ điều khiến dong Io bằng điện áp Vas
nên mô hình tương đường luôn có nguồn dong Io = g Vas

được điều khiến bởi điện cíp Vas

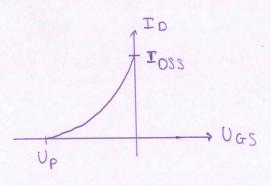
trong cá 3 cách mác Schung, O chung, G chung, thành

Ip = 9VGS

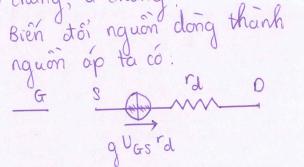
Biến đối nguồn dong thành



Doi voi JEET- DMOSFET



$$g = \frac{-2I_{DSS}}{U_{p}} \left( 1 - \frac{U_{GSQ}}{U_{p}} \right)$$



DE VOI E MOSFET

ID (on)

ID (on)

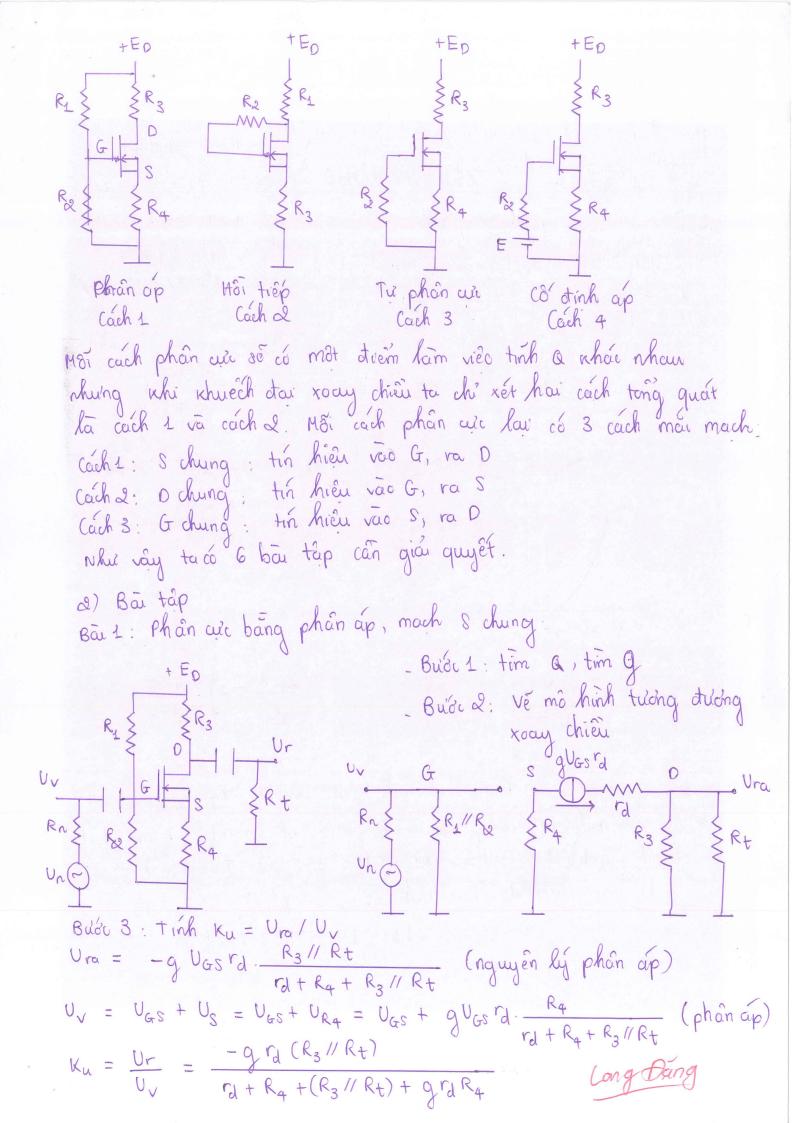
UT UGS (on) UGS

$$g = 2k \left( U_{GSQ} - U_{T} \right)$$

$$K = \frac{I_{D}(on)}{\left( U_{GS}(on) - U_{T} \right)^{\alpha}}$$

Như vây g phụ thuộc điểm làm việc tinh Q Trước khi phân tích mạch khuếch đai xoay chiều thi phải tim điểm làm việc tính Q. Có 3 loại FET là JFET, DMOSFET, EMOSFET nhưng ta chỉ xét DMOSFET làm tổng quát vi nó làm việc được với mọi UGS Ta có cách phân của có bản như sau:

Lang Dang



Bush t: Tinh 
$$Z_V = R_1 / R_2$$

Bush S: Tinh  $Z_T = ?$ 

Uho  $U_V = 0 \Rightarrow q U_{GS} r_{J} r_{g} an mach \Rightarrow Z_T = R_3 / (r_{J} + R_{+})$ 

Bush S: Tinh  $K_U t_P = U_{To} / U_{To}$ 

Kutp =  $\frac{U_{To}}{U_{D}} = \frac{U_{To}}{U_{V}} = \frac{U_{V}}{U_{D}} = \frac{Z_{V}}{R_{+}}$ 

Bush 1: Tinh  $K_U = It / I_{V}$ 

Ki =  $\frac{It}{I_{V}} = \frac{U_{To}}{R_{+}} = \frac{U_{V}}{U_{V}} = K_{U} = \frac{Z_{V}}{R_{+}}$ 

Bush 2: Phun wit bằng phân áp, moch 0 chung:

Bush 2: Vi mô hình thương đường than diệt là thương đường thuộng thuộng

